

[Claim(s)]

[Claim 1] A semiconductor device characterized by having the
5 1st heat sink, the 1st high temperature conductivity insulating
substrate on said 1st heat sink, a semiconductor device on said
1st high temperature conductivity insulating substrate, and the
2nd high temperature conductivity insulating substrate on said
semiconductor device.

10 [Claim 2] A semiconductor device according to claim 1
characterized by having the 2nd heat sink further on said 2nd
high temperature conductivity insulating substrate.

[0013] (The 1st example) Drawing 1 is cross-section structural
15 drawing of the semiconductor device concerning the 1st example
of the gestalt of operation of this invention. As shown in drawing
1 , a semiconductor device is equipped with the 1st heat sink
2, the 1st high temperature conductivity insulating substrate
41 arranged on the 1st heat sink 2, two or more semiconductor
20 devices 51-54 mounted on the 1st high temperature conductivity
insulating substrate 41, the 2nd high temperature conductivity
insulating substrate 71 which fixed on the semiconductor device
51-54, and the 2nd heat sink 8 arranged on the 2nd high
temperature conductivity insulating substrate 71, and is built.

25

[0018] Semiconductor devices 51-54 are formed with the
semiconductor chip (Si chip) in the 1st example, and a power
transistor or high resisting pressure transistors, such as IGBT

and IEGT, are carried at least in semiconductor devices 51-54 by each. In the 1st example, semiconductor devices 51-54 are mounted by each by the face-up method on the surface of the 1st high temperature conductivity insulating substrate 41. Drawing
5 2 is the expanded sectional view of the surface portion of semiconductor devices 51-54. On the surface of semiconductor devices 51-54, the electrode 501 for external connection (bonding pad) drawn from the terminal of a transistor is arranged. The surface center section of the electrode 501 is exposed from
10 the bonding opening 503 formed in the passivation film 502, bonding of the end side of the wire wiring 61 is carried out to the surface of an electrode 501 through this bonding opening 503, and between both sides is connected electrically. As shown in drawing 1 , bonding of the other end side of the wire wiring
15 61 is carried out to one electrode 501 of other semiconductor devices 51-54. Moreover, it connects electrically through the wire wiring 62 between the electrode 501 side of semiconductor devices 51-54, and the other end side of the external lead wiring 3. Cu wire wiring, aluminum wire wiring, Au wire wiring, etc.
20 can use all for the wire wiring 61 and 62 practical.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-174180

(P 2 0 0 0 - 1 7 4 1 8 0 A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード (参考)
H01L 23/36		H01L 23/36	D 5F036
25/07		25/04	C
25/18			

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全12頁)

(21)出願番号	特願平10-343267	(71)出願人	595019599 芝府エンジニアリング株式会社 東京都府中市東芝町1番地
(22)出願日	平成10年12月2日(1998.12.2)	(71)出願人	000003078 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者	奥富 功 東京都府中市東芝町1番地 芝府エンジニアリング株式会社内
		(74)代理人	100083806 弁理士 三好 秀和 (外7名)

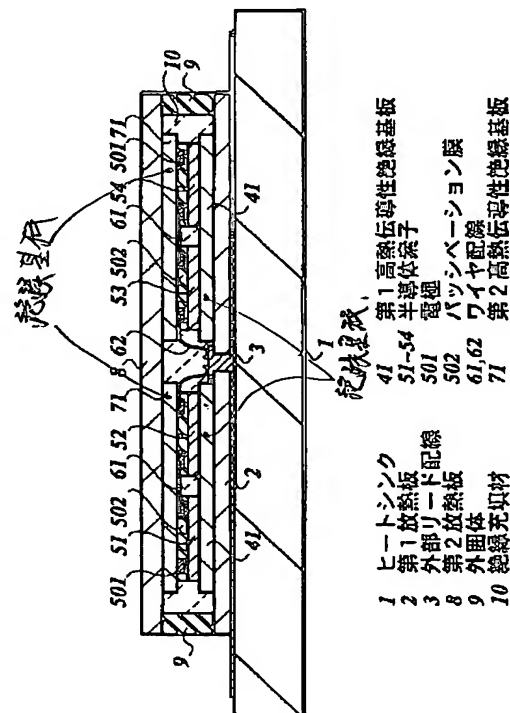
最終頁に続く

(54)【発明の名称】半導体装置

(57)【要約】

【課題】 半導体素子の回路動作で発生する熱の放熱効率を向上させることができ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供する。

【解決手段】 半導体装置において、第1放熱板2上に第1高熱伝導性絶縁基板41を介在させて半導体素子51～54が実装され、この半導体素子51～54上にはさらに第2高熱伝導性絶縁基板71を介在させて第2放熱板8が装着される。半導体素子51～54で発生した熱は上下2方向から冷却される。さらに第1放熱板2下にはヒートシンク1が配設される。半導体素子51～54と第2高熱伝導性絶縁基板71との間は、熱的良導体である高熱伝導性接着材により固着され、また圧接される。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 放熱板と、

前記第 1 放熱板上の第 1 高熱伝導性絶縁基板と、
前記第 1 高熱伝導性絶縁基板上の半導体素子と、
前記半導体素子上の第 2 高熱伝導性絶縁基板と、
を備えたことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 前記第 2 高熱伝導性絶縁基板上にさらに第 2 放熱板を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】 少なくとも前記半導体素子と第 1 高熱伝導性絶縁基板又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間が高熱伝導性接着材により固着されたことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 4】 少なくとも前記半導体素子と第 1 高熱伝導性絶縁基板又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間が圧接されたことを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の半導体装置。

【請求項 5】 少なくとも前記第 1 放熱板、第 2 放熱板、第 1 高熱伝導性絶縁基板、第 2 高熱伝導性絶縁基板のいずれか 1 つの側面にさらに放熱フィンを備えたことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置に関し、特に発熱量の大きな半導体素子を複数個集めてモジュール化した半導体装置に関する。さらに、本発明は冷却構造を有する半導体装置に関する。

【0002】

【従来の技術】パワートランジスタを備えた半導体素子（半導体チップ）を複数個集めてモジュール化した半導体装置（モジュール型半導体装置）はその冷却効率を高めることが重要な技術的課題の 1 つになっている。この種の半導体装置は、放熱板と、この放熱板上に固着された高熱伝導性絶縁基板と、この高熱伝導性絶縁基板上に複数個実装された半導体素子と、高熱伝導性絶縁基板及び半導体素子を取り囲む外囲体とを備えて構築される。放熱板及び外囲体は半導体素子及び高熱伝導性絶縁基板を収納するキャビティを形成し、このキャビティ内には絶縁性ゲルが充填される。放熱板の裏面にはヒートシンクが取り付けられている。

【0003】このように構成された半導体装置においては、半導体素子の回路動作で発生する熱が高熱伝導性絶縁基板を通して放熱板に伝達され、この放熱板はヒートシンクにより冷却される。従って、半導体素子の熱による動作不良や熱破損を防止することができるので、半導体装置の信頼性を向上させることができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の半導体装置においては、半導体素子で発生した熱の主な

る放熱経路が、半導体素子裏面から高熱伝導性絶縁基板、放熱板のそれぞれを通過してヒートシンクに至る 1 つの経路（1 つの方向）しか確保されていない。しかも、今後の半導体装置は少なくとも高耐圧化又は大電流化を目的とした大容量化の傾向にあり、半導体素子からの発熱量がさらに増大することが予測されている。このため、冷却能力に限界があるので、今後の半導体装置の大容量化に対処することができないという問題があった。

【0005】本発明は上記課題を解決するためになされたものである。従って、本発明の目的は、半導体素子の回路動作で発生する熱の放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することである。

【0006】さらに、本発明の目的は、放熱経路の熱抵抗を減少させることにより放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することである。

【0007】さらに、本発明の目的は、放熱面積を増加させることにより放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することである。

【0008】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、この発明の第 1 の特徴は、半導体装置において、第 1 放熱板と、第 1 放熱板上の第 1 高熱伝導性絶縁基板と、第 1 高熱伝導性絶縁基板上の半導体素子と、半導体素子上の第 2 高熱伝導性絶縁基板と、を備えたことである。さらに、この発明の第 1 の特徴は、半導体装置において、第 2 高熱伝導性絶縁基板上に第 2 放熱板を備えたことである。半導体素子は回路動作による熱発生量が多いパワートランジスタを備えたものであることが好ましい。特に、複数個の半導体素子でモジュールを構築した半導体装置に適用されることが好ましい。第 1 放熱板、第 2 放熱板にはそれぞれ熱抵抗値の小さい Cu 板、AlN 板が実用的に使用できる。第 1 高熱伝導性絶縁基板、第 2 高熱伝導性絶縁基板には、それぞれ、AlN 基板の両面に Al 層を形成したダイレクトボンディングアルミニウム（DBA）基板、AlN 基板の両面に Cu 層を形成したダイレクトボンディングカッパー（DBC）基板が実用的に使用できる。第 1 放熱板の周囲、第 2 放熱板の周囲には外囲体が配設されており、第 1 放熱板、第 2 放熱板及び外囲体で形成されるキャビティ内部に半導体素子が収納されるときにこのキャビティ内部には絶縁充填材が充填されることが好ましい。絶縁充填材には絶縁性ゲル、好ましくはシリコングルやフロリナートが実用的に使用できる。第 1 放熱板、第 2 放熱板の少なくともいずれか一方にはヒートシンクが配設されることが好ましく、ヒートシンクは少なくともいずれかの放熱板を冷却することができる。このように構成される半導体装置において

は、半導体素子の回路動作で発生する熱の放熱経路は、第 1 高熱伝導性絶縁基板及び第 1 放熱板を通過する経路と、第 2 高熱伝導性絶縁基板及び第 2 放熱板を通過する経路との半導体素子の上下 2 方向に確保することができる。つまり、放熱経路の複数化を実現することができる。つまり、放熱経路が複数化されることで放熱経路の熱抵抗を減少させることができる。さらに加えて、放熱経路に熱抵抗が小さい第 1 及び第 2 高熱伝導性絶縁基板を介在させているので、放熱経路全体の熱抵抗をさらに減少させることができる。従って、半導体素子で発生した熱の放熱効率を向上させ、半導体装置の冷却効率を向上させることができる。

【0009】この発明の第 2 の特徴は、第 1 の特徴の半導体装置において、少なくとも半導体素子と第 1 高熱伝導性絶縁基板又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間が高熱伝導性接着材により固着されたことである。高熱伝導性接着剤による固着は、少なくとも半導体素子の電極が配設された面と高熱伝導性絶縁基板との間で行われる必要がある。半導体素子の下面に電極が配設される場合には第 1 高熱伝導性絶縁基板との間で、半導体素子の上面に電極が配設される場合には第 2 高熱伝導性絶縁基板との間で行われる。高熱伝導性接着材には半田 (Pb-Sn 合金)、Ag ろう、Cu ろうのいずれかが実用的に使用できる。このように構成される半導体装置においては、半導体素子の電極が配設された面と第 1 又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間の微小な隙間を熱抵抗の小さい高熱伝導性接着材で埋め込み、放熱経路の熱抵抗を低減させることができるので、冷却効率をより一層向上させることができる。

【0010】この発明の第 3 の特徴は、第 1 の特徴又は第 2 の特徴の半導体装置において、少なくとも半導体素子と第 1 高熱伝導性絶縁基板又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間が圧接されることである。圧接は、少なくとも半導体素子の電極 (ボンディングパッド) が配設された面と高熱伝導性絶縁基板との間で行われる必要がある。半導体素子の下面に電極が配設される場合には第 1 高熱伝導性絶縁基板との間で、半導体素子の上面に電極が配設される場合には第 2 高熱伝導性絶縁基板との間で行われる。圧接は第 1 放熱板と第 2 放熱板との間を締め付けるボルト締結により行うことが好ましい。さらに、圧接はプレス機械により行うこともできる。このように構成される半導体装置においては、半導体素子の電極が配設された面と第 1 又は第 2 高熱伝導性絶縁基板との間の真実接触面積を増加させ (双方の接触を点接触から面接触に代え)、放熱経路の熱抵抗を低減させることができるので、冷却効率をより一層向上させることができる。

【0011】この発明の第 4 の特徴は、第 1 の特徴乃至第 3 の特徴のいずれかの半導体装置において、少なくとも第 1 放熱板、第 2 放熱板、第 1 高熱伝導性絶縁基板、第 2 高熱伝導性絶縁基板のいずれか 1 つの側面にさらに

放熱フィンを備えたことである。このように構成される半導体装置においては、第 1 放熱板、第 2 放熱板、第 1 高熱伝導性絶縁基板、第 2 高熱伝導性絶縁基板のいずれかの放熱面積を増加させることができるので、放熱効率をより一層向上させることができる。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0013】(第 1 の実施例) 図 1 は本発明の実施の形態の第 1 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。図 1 に示すように、半導体装置は、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 上に実装された複数個の半導体素子 5 1 ~ 5 4 と、半導体素子 5 1 ~ 5 4 上に固着された第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される。

【0014】第 1 放熱板 2 の周囲と第 2 放熱板 8 の周囲との間には外囲体 9 が配設される。この外囲体 9、第 1 放熱板 2 及び第 2 放熱板 8 は内部がキャビティとなる密閉封止体を構築し、密閉封止体のキャビティ内部には半導体素子 5 1 ~ 5 4、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 及び第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 が収納される。キャビティ内部には絶縁性充填材 1 0 が充填される。絶縁性充填材 1 0 には第 1 の実施例において絶縁性ゲル、詳細にはシリコーンゲルが使用される。

【0015】第 1 放熱板 2 の裏面側にはヒートシンク 1 が取り付けられ、第 1 の実施例においてはヒートシンク 1 は半導体装置の下側片面だけに取り付けられる。ヒートシンク 1 は、半導体素子 5 1 ~ 5 4 の回路動作で発生し第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 を通して第 1 放熱板 8 に伝達された熱を冷却する機能を有する。ヒートシンク 1 には例えば Cu 製水冷ヒートシンクが実用的に使用できる。また、ヒートシンク 1 には Cu 製空冷ヒートシンクを使用してもよい。

【0016】第 1 放熱板 2、第 2 放熱板 8 にはいずれも熱的良導体である例えば Cu 板、AlN 板が実用的に使用できる。第 1 放熱板 2 とヒートシンク 1 との間には一端側が半導体装置の外部に導出され、他端側が前述の密閉封止体のキャビティ内部に導出された外部リード配線 3 が配設される。外部リード配線 3 は例えば Cu 薄膜で形成され、詳細に図示していないが外部リード配線 3 の表面には両端部 (接続部) を除き絶縁コーティングが施されている。

【0017】第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 のそれぞれには、熱的良導体である AlN 基板の両面に Al 層を形成したダイレクトボンディングアルミニウム (DBA) 基板、又は AlN 基板の両面に Cu 層を形成したダイレクトボンディングカッパー (DBC) 基板を実用的に使用することができる。

【0018】半導体素子51～54は第1の実施例において半導体チップ (Siチップ) で形成されており、半導体素子51～54にはいずれも少なくともIGBT、IEGT等のパワートランジスタ又は高耐圧トランジスタが搭載される。第1の実施例において半導体素子51～54はいずれも第1高熱伝導性絶縁基板41の表面上にフェースアップ方式で実装される。図2は半導体素子51～54の表面部分の拡大断面図である。半導体素子51～54の表面上にはトランジスタの端子から導出された外部接続用電極 (ボンディングパッド) 501が配設される。電極501の表面中央部はパッシベーション膜502に形成されたボンディング開口503から露出されており、このボンディング開口503を通して電極501の表面にはワイヤ配線61の一端側がボンディングされ、双方の間が電氣的に接続される。図1に示すように、ワイヤ配線61の他端側は他の半導体素子51～54のいずれかの電極501にボンディングされる。また、半導体素子51～54の電極501と外部リード配線3の他端側との間はワイヤ配線62を通して電氣的に接続される。ワイヤ配線61、62にはいずれも例えばCuワイヤ配線、Alワイヤ配線、Auワイヤ配線等が実用的に使用できる。

【0019】図2に示すように、半導体素子51～54のそれぞれと第2高熱伝導性絶縁基板71との間は、半導体素子51～54のそれぞれの電極501が配設された側のパッシベーション膜502の表面と第2高熱伝導性絶縁基板71の裏面との間に高熱伝導性接着材101を介在させて、熱的かつ機械的に固着される。高熱伝導性接着材101には熱的良導体である例えば半田、好ましくはPb-Sn合金、さらに好ましくはPb-Sn共晶合金が実

用的に使用できる。

【0020】同図2に示すように、半導体素子51～54のそれぞれのパッシベーション膜502の表面や第2高熱伝導性絶縁基板71の裏面には微視的に見れば微小な凹凸が存在し、単純に接触させた場合には双方の界面にランダムに隙間が発生する。第1の実施の形態に係る半導体装置においては、このような微小な隙間に熱的良導体である高熱伝導性接着材101を埋込み、半導体素子51～54のそれぞれと第2高熱伝導性絶縁基板71との間の熱抵抗を減少させることができる。第1の実施例において半導体素子51～54のそれぞれは第1高熱伝導性絶縁基板41上にフェースアップ方式で実装されているので、半導体素子51～54のそれぞれと第2高熱伝導性絶縁基板71との間に高熱伝導性接着材101が形成されているが、第1高熱伝導性絶縁基板41上にフェースダウン方式で半導体素子51～54のそれぞれが実装される場合には第1高熱伝導性絶縁基板41と半導体素子51～54のそれぞれとの間に高熱伝導性接着材101が形成される。なお、高熱伝導性接着材101においては、高温度での使用になってしまうが、Agろう

やCuろうを使用することができる。

【0021】図4は本発明の実施の形態の各実施例 (第1の実施例～第13の実施例) に係る構成 (積層構造)、接続形式、通電による半導体素子の温度上昇値のそれぞれの関係を示す図である。同図4に示すように、第1の実施例に係る半導体装置の構成は、下記のように各記号を定義した場合、 $D+C/B/A/B/C$ で表すことができる。

A: 半導体素子 (51～54)

B: 高熱伝導性絶縁基板 (41, 71)

C: 放熱板 (2, 8)

D: ヒートシンク (1)

/: 固着

+: 圧接

さらに、図4には第1高熱伝導性絶縁基板41及び第2高熱伝導性絶縁基板71の具体的な構造 (Al/AlN/A1)、絶縁充填材10の具体的な材料 (シリコーンゲル) のそれぞれが表記されている。ここで、図4に示す初段には各実施例と構成並びに温度上昇特性とを比較するための比較例に係る半導体装置の構成等を表記した。図3は比較例に係る半導体装置の断面構造図である。この比較例に係る半導体装置は、放熱板21上に高熱伝導性絶縁基板40を配設し、この高熱伝導性絶縁基板40上に半導体素子59A及び59Bを実装したものである。第1の実施例に係る半導体装置と同様に、放熱板21下にはヒートシンク1が配設され、半導体素子59A及び59B等は絶縁充填材10で被覆される。

【0022】比較例に係る半導体装置において、通電を行い、半導体素子59A及び59Bの温度上昇を測定すると、20℃から120℃まで上昇し、100℃の温度上昇が測定された。なお、半導体素子59A及び59Bの温度は、直接測定することができなかったため、ヒートシンク1の温度測定を行い、この測定結果から熱抵抗値等の伝熱計算により算出したものである。

【0023】この比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第1の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.75という結果が得られた。

【0024】このように構成される第1の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子51～54の回路動作で発生する熱の放熱経路は、第1高熱伝導性絶縁基板41及び第1放熱板2を通過する経路と、第2高熱伝導性絶縁基板71及び第2放熱板8を通過する経路との半導体素子51～54の上下2方向に確保することができ、放熱経路の複数化を実現することができる。つまり、放熱経路が複数化されることで放熱経路全体の熱抵抗を減少させることができる。さらに加えて、放熱経路に熱抵抗が小さい第1高熱伝導性絶縁基板41及び第2高熱伝導性絶縁基板71を介在させているので、放熱経路全体の熱抵抗をさらに減少させることができる。従っ

て、半導体素子 51～54 で発生した熱の放熱効率を向上させることができるので、半導体装置の冷却効率を向上させることができる。

【0025】さらに、第 1 の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子 51～54 の電極 501 が配設された面と第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 との間の微小な隙間を熱抵抗の小さい高熱伝導性接着材 101 で埋め込み、放熱経路の熱抵抗を低減させることができるので、冷却効率をより一層向上させることができる。

【0026】(第 2 の実施例) 図 5 は本発明の実施の形態の第 2 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。図 5 に示すように、半導体装置は、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 41 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 41 上に実装された複数の半導体素子 51～54 と、半導体素子 51～54 上に固着された第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 上に実装された複数の半導体素子 55～58 と、半導体素子 55～58 上に配設された第 3 高熱伝導性絶縁基板 42 と、第 3 高熱伝導性絶縁基板 42 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される。すなわち、図 4 に示すように、第 2 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C/B/A/B/A/B/C$ で表記することができる。

【0027】この半導体装置は、第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 を中心に下側に半導体素子 51～54 を配設し、上側に半導体素子 55～58 を配設した 2 層構造で形成される。半導体素子 51～54 は第 1 高熱伝導性絶縁基板 41 上にフェースアップ方式で実装され、半導体素子 55～58 は第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 上にフェースダウン方式で実装される。半導体素子 55～58 のそれぞれの電極 503 間はワイヤ配線 63 で電氣的に接続され、半導体素子 55～58 のそれぞれの電極 503 と外部リード配線 3 の他端側との間はワイヤ配線 64 で電氣的に接続される。

【0028】詳細に図示しないが、第 1 の実施例に係る半導体装置と同様に、半導体素子 51～54 のそれぞれと第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 との間、半導体素子 55～58 のそれぞれと第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 との間は高熱伝導性接着材 101 で熱的かつ機械的に固着される(図 2 参照)。ヒートシンク 1 は第 1 放熱板 2 側にのみ配設される。

【0029】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 2 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.96 という結果が得られた。第 1 の実施例に係る半導体装置に対して第 2 の実施例に係る半導体装置の温度上昇は若干高くなっているが、実装された半導体素子数が多い(発熱量が大きい)点、比較例に比べて温度が低い点を考慮すれば、第 2 の実施例に係る半導体装置においては十分な冷却効率を得られている。

【0030】このように構成される第 2 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができ、加えて半導体素子 51～54 上にさらに半導体素子 55～58 を実装したので、実装密度を向上させることができる。

【0031】(第 3 の実施例) 図 6 は本発明の実施の形態の第 3 の実施例に係る半導体装置の半導体素子の表面部分の拡大断面図である。第 3 の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第 1 の実施例に係る半導体装置と同様に、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 41 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 41 上に実装された複数の半導体素子 51～54 と、半導体素子 51～54 上に圧接された第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される(図 1 参照)。

【0032】但し、第 3 の実施例に係る半導体装置全体には製作段階において厚さ方向に圧力が加えられており、図 6 に示すように、少なくとも半導体素子 51～54 と第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 との間が圧接されている。前述のように、半導体素子 51～54 のそれぞれのパッシベーション膜 502 の表面や第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 の裏面には微視的に見れば微小な凹凸が存在し、単純に接触させた場合には双方は互いに突出した部分が接触する点接触になってしまう。圧接することによりこのような突出した部分は押し潰され、双方の間の接触状態は点接触から面接触に代えることができる。すなわち、双方の間の真実接触面積を増加させ、双方の界面の熱抵抗を減少させることができる。従って、図 4 に示すように、第 3 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C/B/A + B/C$ で表記することができる。

【0033】圧接は例えばプレス機械により行う。圧接は、前述の真実接触面積を最大限に増加させつつ、半導体素子 51～54 に搭載されたトランジスタやパッシベーション膜 502 に損傷を与えない程度の圧接力、例えば数十 kgf/mm² 程度の圧接力で行われる。

【0034】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 3 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.74 という結果が得られた。第 3 の実施例に係る半導体装置は第 1 の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0035】このように構成される第 3 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。さらに、第 3 の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子 51～54 の電極 501 が配設された面と第 2 高熱伝導性絶縁基板 71 との間の真実接触面積を増加させ(双方の接触を点接触から面接触に代え)、放熱経路の熱抵抗を低減させることができるので、冷却効率をより

一層向上させることができる。

【0036】（第4の実施例）第4の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第2の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に圧接された第2高熱伝導性絶縁基板71と、第2高熱伝導性絶縁基板71上に実装されかつ圧接された複数の半導体素子55～58と、半導体素子55～58上に配設された第3高熱伝導性絶縁基板42と、第3高熱伝導性絶縁基板42上に配設された第2放熱板8とを備えて構築される（図2参照）。

【0037】但し、第3の実施例に係る半導体装置と同様に、第4の実施例に係る半導体装置全体には製作段階において厚さ方向に圧力が加えられており、少なくとも半導体素子51～54と第2高熱伝導性絶縁基板71との間、第2高熱伝導性絶縁基板71と半導体素子55～58との間が圧接されている（図6参照）。すなわち、図4に示すように、第4の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A + B + A / B / C$ で表記することができる。

【0038】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第4の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.95という結果が得られた。第4の実施例に係る半導体装置は第2の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0039】このように構成される第4の実施例に係る半導体装置においては、第3の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0040】（第5の実施例）図7は本発明の実施の形態の第5の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。第5の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第4の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に圧接された第2高熱伝導性絶縁基板71と、第2高熱伝導性絶縁基板71上に実装されかつ圧接された複数の半導体素子55～58と、半導体素子55～58上に配設された第3高熱伝導性絶縁基板42と、第3高熱伝導性絶縁基板42上に配設された第2放熱板8とを備えて構築される。

【0041】但し、第5の実施例に係る半導体装置は、第4の実施例に係る半導体装置と同様に厚さ方向に圧力が加えられているが、図7に示すように圧接力をボルト締結体110により得ている。ボルト締結体110は第1放熱板2と第2放熱板8との間を締め付けるように構成されている。図4に示すように、第5の実施例に係る

半導体装置の構成は $D + C / B / A + B + A / B / C$ で表記することができる。

【0042】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第5の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.94という結果が得られた。第5の実施例に係る半導体装置は第4の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0043】このように構成される第5の実施例に係る半導体装置においては、第4の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0044】（第6の実施例）図8は本発明の実施の形態の第6の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。第6の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第1の実施例又は第3の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に固着された第2高熱伝導性絶縁基板71と、第2高熱伝導性絶縁基板71上に配設された第2放熱板8とを備えて構築される。さらに、ヒートシンク1は第1放熱板2の下側だけに片側配置であるが、第6の実施例に係る半導体装置においては、第1放熱板2の周囲と第2放熱板8の周囲との間が熱的良導体である高放熱伝導体111により少なくとも熱的に結合されている。すなわち、第6の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子51～54から第2放熱板8、高放熱伝導体111のそれぞれを通過しヒートシンク1に至る新たな放熱経路（バイパス放熱経路）を構築することができる。高放熱伝導体111は例えばCuやAlNからなる枠体で形成される。図4に示すように、第6の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A / B / C$ で表記することができる。

【0045】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第6の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.70という結果が得られた。第6の実施例に係る半導体装置は第1の実施例、第3の実施例に係る半導体装置を上回る冷却効率を得ることができる。

【0046】このように構成される第6の実施例に係る半導体装置においては、第1の実施例、第3の実施例に係るそれぞれの半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。さらに、第6の実施例に係る半導体装置においては、第2放熱板8からヒートシンク1に至る放熱経路を高放熱伝導体111で構築することができるので、放熱経路全体の熱抵抗をさらに削減することができ、冷却効率をより一層向上させることができる。

【0047】（第7の実施例）図9は本発明の実施の形態の第7の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。第7の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が

第6の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数個の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に固着された第2高熱伝導性絶縁基板71と、第2高熱伝導性絶縁基板71上に配設された第2放熱板8と、第1放熱板2と第2放熱板8（又はヒートシンク1）との間を熱的に接続する高放熱伝導体111とを備えて構築される。さらに、第7の実施例に係る半導体装置においては、第1放熱板2の下側に配設されたヒートシンク1に加えて、第2放熱板8の上側にもヒートシンク11が配設される。図4に示すように、第7の実施例に係る半導体装置の構成は $D+C/B/A/B/C+D$ で表記することができる。

【0048】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第7の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.61という結果が得られた。第7の実施例に係る半導体装置はすべての実施例中で最も高い冷却効率を得ることができる。

【0049】このように構成される第7の実施例に係る半導体装置においては、第6の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。さらに、第7の実施例に係る半導体装置においては、上下それぞれにヒートシンク1及び11を配設したので、冷却効率をより一層向上させることができる。

【0050】（第8の実施例）図10は本発明の実施の形態の第8の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。第8の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第1の実施例に係る半導体装置と類似するように、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数個の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に固着された第2高熱伝導性絶縁基板71とを備えて構築される。すなわち、第8の実施例に係る半導体装置は、第2高熱伝導性絶縁基板71上に第2放熱板8が配設されておらず、第2高熱伝導性絶縁基板71の上面が絶縁充填材10で覆われていない剥き出しの状態で形成される。この第2高熱伝導性絶縁基板71の剥き出しの状態にある表面は直接冷風が吹き付けられ空冷される。図4に示すように、第8の実施例に係る半導体装置の構成は $D+C/B/A/B$ で表記することができる。

【0051】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第8の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.83という結果が得られた。第8の実施例に係る半導体装置は、各実施例に係る半導体装置に比べて温度上昇は若干高くなっているが、第2高熱伝導性絶縁基板71の剥き出しの状態にある表面を直接冷風により空冷し

ているので、比較例に比べて充分に高い冷却効率を得ることができる。

【0052】このように構成される第8の実施例に係る半導体装置においては、第1の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。さらに、第2放熱板8を配設しないので、半導体装置の冷却構造をシンプルにすることができる。

【0053】（第9の実施例）図11は本発明の実施の形態の第9の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。第9の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第1の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数個の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に固着された第2高熱伝導性絶縁基板71と、第2高熱伝導性絶縁基板71上に配設された第2放熱板8とを備えて構築される。

【0054】さらに、第9の実施例に係る半導体装置は、第1高熱伝導性絶縁基板41、第2高熱伝導性絶縁基板71のそれぞれの側面周囲に放熱フィン401が装着される。放熱フィン401は機械的な切削加工やエッチング加工により簡易に製作することができる。放熱フィン401により第1高熱伝導性絶縁基板41、第2高熱伝導性絶縁基板71のそれぞれの側面の表面積は1.1～1.5倍程度増加させることができる。さらに、第9の実施例に係る半導体装置においては、第1放熱板2、第2放熱板8のそれぞれの側面周囲に放熱フィンを装着させることができる。図4に示すように、第9の実施例に係る半導体装置の構成は $D+C/B/A/B/C$ で表記することができる。

【0055】図4に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値1として、同様に第3の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として0.72という結果が得られた。第9の実施例に係る半導体装置は第1の実施例に係る半導体装置を上回る冷却効率を得ることができる。

【0056】このように構成される第9の実施例に係る半導体装置においては、第1の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。さらに、第9の実施例に係る半導体装置においては、第1放熱板2、第2放熱板8、第1高熱伝導性絶縁基板41、第2高熱伝導性絶縁基板71のいずれかの放熱面積を増加させることができるので、放熱効率をより一層向上させることができる。

【0057】（第10の実施例）第10の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第1の実施例に係る半導体装置と同様に、第1放熱板2と、第1放熱板2上に配設された第1高熱伝導性絶縁基板41と、第1高熱伝導性絶縁基板41上に実装された複数個の半導体素子51～54と、半導体素子51～54上に固着された第2高

熱伝導性絶縁基板 7 1 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される (図 1 参照)。そして、第 1 0 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 のそれぞれが DBC (Cu/AlN/Cu) 基板で形成される。図 4 に示すように、第 1 0 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A / B / C$ で表記することができる。

【0058】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 1 0 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.71 という結果が得られた。第 1 0 の実施例に係る半導体装置は第 1 の実施例に係る半導体装置を上回る冷却効率を得ることができる。

【0059】このように構成される第 1 0 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0060】(第 1 1 の実施例) 第 1 1 の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第 1 の実施例に係る半導体装置と同様に、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 上に実装された複数個の半導体素子 5 1 ~ 5 4 と、半導体素子 5 1 ~ 5 4 上に固着された第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される (図 1 参照)。そして、第 1 1 の実施例に係る半導体装置においては、絶縁充填材 10 にフロリナートが使用される。図 4 に示すように、第 1 1 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A / B / C$ で表記することができる。

【0061】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 1 1 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.74 という結果が得られた。第 1 1 の実施例に係る半導体装置は第 1 の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0062】このように構成される第 1 1 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0063】(第 1 2 の実施例) 第 1 2 の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第 1 の実施例に係る半導体装置と同様に、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 上に実装された複数個の半導体素子 5 1 ~ 5 4 と、半導体素子 5 1 ~ 5 4 上に固着された第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される (図 1 参照)。そして、図示しないが、第 1 2 の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子 5 1 ~ 5 4 のそれぞれの電極 5 0 1 間の接続がビームリードで行われる。

ビームリードは、例えば Cu 板、Fe-Ni 板等の電気的かつ熱的良導体を打ち抜き加工やエッチング加工でパターンニングしたものであり、第 1 の実施例に係る半導体装置のワイヤ配線 6 1 に比べて断面積が大きく、電流量が増加できるとともに熱抵抗を減少させることができる。図 4 に示すように、第 1 1 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A / B / C$ で表記することができる。

【0064】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 1 2 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.75 という結果が得られた。第 1 2 の実施例に係る半導体装置は第 1 の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0065】このように構成される第 1 2 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0066】(第 1 3 の実施例) 第 1 3 の実施例に係る半導体装置は、基本的な構造が第 1 の実施例に係る半導体装置と同様に、第 1 放熱板 2 と、第 1 放熱板 2 上に配設された第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 と、第 1 高熱伝導性絶縁基板 4 1 上に実装された複数個の半導体素子 5 1 ~ 5 4 と、半導体素子 5 1 ~ 5 4 上に固着された第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 と、第 2 高熱伝導性絶縁基板 7 1 上に配設された第 2 放熱板 8 とを備えて構築される (図 1 参照)。そして、図示しないが、第 1 3 の実施例に係る半導体装置においては、半導体素子 5 1 ~ 5 4 のそれぞれの電極 5 0 1 間の接続が熱的良導体である DBC 基板をベースとした配線基板で行われる。図 4 に示すように、第 1 3 の実施例に係る半導体装置の構成は $D + C / B / A / B / C$ で表記することができる。

【0067】図 4 に示すように、比較例に係る半導体装置の温度上昇の値を基準値 1 として、同様に第 1 3 の実施例に係る半導体装置の温度上昇を測定すると、相対値として 0.79 という結果が得られた。第 1 3 の実施例に係る半導体装置は第 1 の実施例に係る半導体装置と同等の冷却効率を得ることができる。

【0068】このように構成される第 1 3 の実施例に係る半導体装置においては、第 1 の実施例に係る半導体装置で得られる効果と同様の効果を得ることができる。

【0069】

【発明の効果】本発明は、半導体素子の回路動作で発生する熱の放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することができる。

【0070】さらに、本発明は、放熱経路の熱抵抗を減少させることにより放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させることにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することができる。

【0071】さらに、本発明は、放熱面積を増加させることにより放熱効率を向上させ、冷却効率を向上させる

ことにより大容量化を実現することができる半導体装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の実施の形態の第 1 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 2】本発明の実施の形態の第 1 の実施例に係る半導体素子の表面部分の拡大断面図である。

【図 3】本発明の実施の形態の各実施例と比較するための比較例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 4】本発明の実施の形態の各実施例に係る構成、接続形式、通電による半導体素子の温度上昇値のそれぞれ 10 の関係を示す図である。

【図 5】本発明の実施の形態の第 2 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 6】本発明の実施の形態の第 3 の実施例に係る半導体装置の半導体素子の表面部分の拡大断面図である。

【図 7】本発明の実施の形態の第 5 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 8】本発明の実施の形態の第 6 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 9】本発明の実施の形態の第 7 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

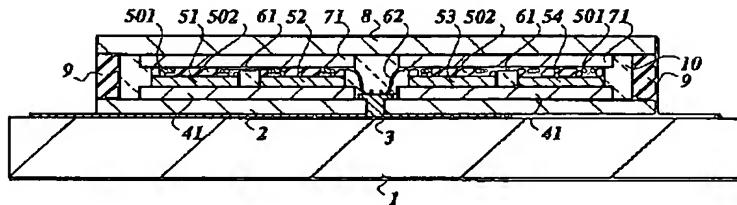
【図 10】本発明の実施の形態の第 8 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【図 11】本発明の実施の形態の第 9 の実施例に係る半導体装置の断面構造図である。

【符号の説明】

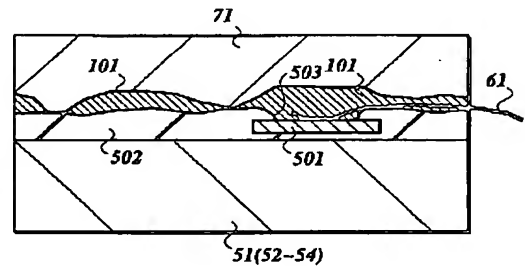
- 1, 11 ヒートシンク
- 2 第 1 放熱板
- 3 外部リード配線
- 41 第 1 高熱伝導性絶縁基板
- 42 第 3 高熱伝導性絶縁基板
- 51～58 半導体素子
- 501 電極
- 502 パッシベーション膜
- 61～64 リード配線
- 71 第 2 高熱伝導性絶縁基板
- 8 第 2 放熱板
- 9 外圍体
- 10 絶縁充填材
- 101 高熱伝導性接着材
- 110 ボルト締結
- 111 高放熱伝導体

【図 1】



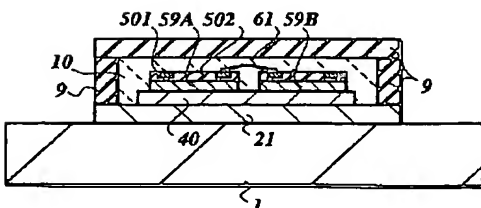
- 1 ヒートシンク
- 2 第 1 放熱板
- 3 外部リード配線
- 8 第 2 放熱板
- 9 外圍体
- 10 絶縁充填材
- 41 第 1 高熱伝導性絶縁基板
- 51-54 半導体素子
- 501 電極
- 502 パッシベーション膜
- 61, 62 ワイヤ配線
- 71 第 2 高熱伝導性絶縁基板

【図 2】



- 51(52-54) 半導体素子
- 501 電極
- 502 パッシベーション膜
- 61 ワイヤ配線
- 71 第 2 高熱伝導性絶縁基板
- 101 高放熱伝導性接着材

【図 3】



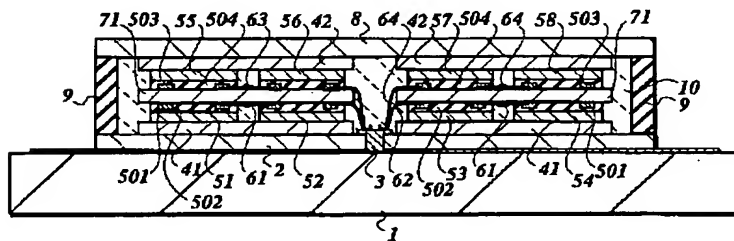
【図4】

比較例 又は 実施例	条 件			接 続 形 式	結 果 半導体素子 の上昇温度
	構 成	B 絶縁基板	絶縁充填材		
比較例	D+C/B/A	Al/AlN/Al	シリコン		I(基準)
実施例 1	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	固 着	0.75
実施例 2	D+C/B/A/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	固 着	0.96
実施例 3	D+C/B/A+B/C	Al/AlN/Al	シリコン	圧 接	0.74
実施例 4	D+C/B/A+B+A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	圧 接	0.95
実施例 5	D+C/B/A+B+A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	C 同士のボルト締結	0.94
実施例 6	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	C 同士の高熱伝導接合	0.70
実施例 7	D+C/B/A/B/C+D	Al/AlN/Al	シリコン	C 同士の高熱伝導接合	0.61
実施例 8	D+C/B/A/B	Al/AlN/Al	シリコン	B の空冷	0.83
実施例 9	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	放熱フィン装着	0.72
実施例 10	D+C/B/A/B/C	Cu/AlN/Cu	シリコン		0.71
実施例 11	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	フッ素ナート		0.74
実施例 12	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	ビームリード接続	0.75
実施例 13	D+C/B/A/B/C	Al/AlN/Al	シリコン	Cu/AlN/Cuで接続	0.79

A: 半導体素子 B: 高熱伝導性絶縁基板 C: 放熱板 D: ヒートシンク

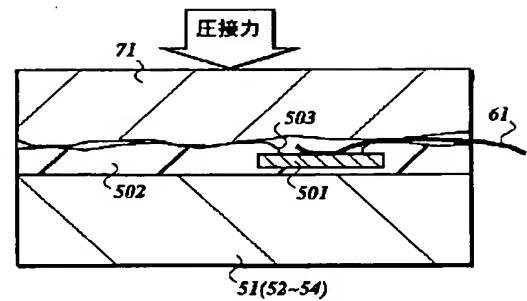
/: 固着 +: 圧接

【図5】



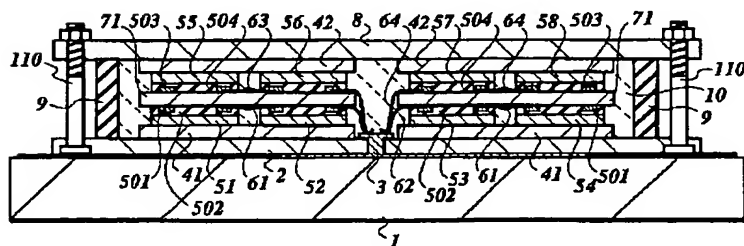
- | | |
|-----------|--------------------|
| 1 ヒートシンク | 41 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 第1放熱板 | 42 第3高熱伝導性絶縁基板 |
| 3 外部リード配線 | 51-58 半導体素子 |
| 8 第2放熱板 | 501, 503 電極 |
| 9 外囲体 | 502, 504 バッシペーション膜 |
| 10 絶縁充填材 | 61-64 ワイヤ配線 |
| | 71 第2高熱伝導性絶縁基板 |

【図6】



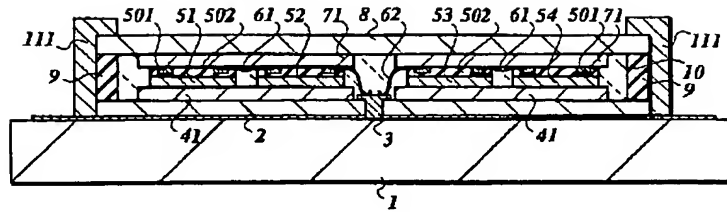
- | |
|-----------------|
| 51(52-54) 半導体素子 |
| 501 電極 |
| 502 バッシペーション膜 |
| 61 ワイヤ配線 |
| 71 第2高熱伝導性絶縁基板 |

【図7】



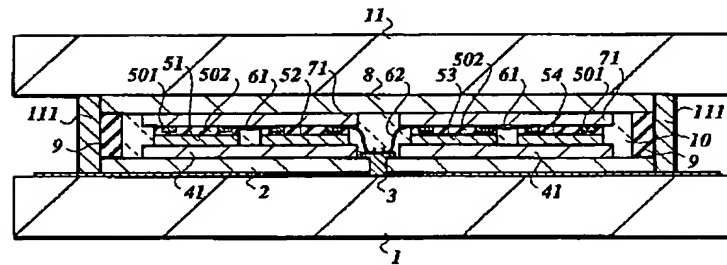
- | | |
|-----------|--------------------|
| 1 ヒートシンク | 41 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 第1放熱板 | 42 第3高熱伝導性絶縁基板 |
| 3 外部リード配線 | 51-58 半導体素子 |
| 8 第2放熱板 | 501, 503 電極 |
| 9 外囲体 | 502, 504 バッシペーション膜 |
| 10 絶縁充填材 | 61-64 ワイヤ配線 |
| | 71 第2高熱伝導性絶縁基板 |
| | 110 ボルト締結体 |

【図8】



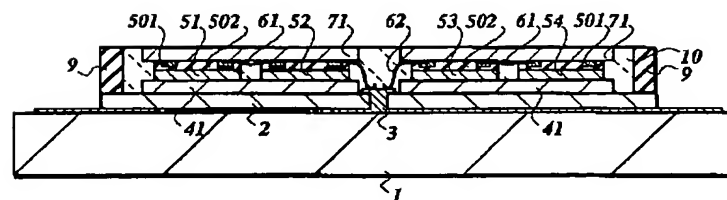
- | | | | |
|----|---------|--------|-------------|
| 1 | ヒートシンク | 41 | 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 | 第1放熱板 | 51~54 | 半導体素子 |
| 3 | 外部リード配線 | 501 | 電極 |
| 8 | 第2放熱板 | 502 | パッシベーション膜 |
| 9 | 外固体 | 61, 62 | ワイヤ配線 |
| 10 | 絶縁充填材 | 71 | 第2高熱伝導性絶縁基板 |
| | | 111 | 高放熱伝導体 |

【図9】



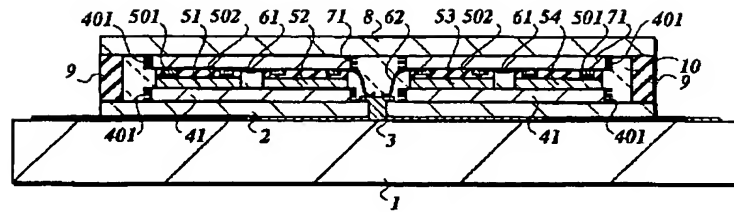
- | | | | |
|-------|---------|--------|-------------|
| 1, 11 | ヒートシンク | 41 | 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 | 第1放熱板 | 51~54 | 半導体素子 |
| 3 | 外部リード配線 | 501 | 電極 |
| 8 | 第2放熱板 | 502 | パッシベーション膜 |
| 9 | 外固体 | 61, 62 | ワイヤ配線 |
| 10 | 絶縁充填材 | 71 | 第2高熱伝導性絶縁基板 |
| | | 111 | 高放熱伝導体 |

【図10】



- | | | | |
|----|---------|--------|-------------|
| 1 | ヒートシンク | 41 | 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 | 第1放熱板 | 51~54 | 半導体素子 |
| 3 | 外部リード配線 | 501 | 電極 |
| 9 | 外固体 | 502 | パッシベーション膜 |
| 10 | 絶縁充填材 | 61, 62 | ワイヤ配線 |
| | | 71 | 第2高熱伝導性絶縁基板 |

【図 11】



- | | | | |
|----|---------|--------|-------------|
| 1 | ヒートシンク | 41 | 第1高熱伝導性絶縁基板 |
| 2 | 第1放熱板 | 401 | 放熱フィン |
| 3 | 外部リード配線 | 51~54 | 半導体素子 |
| 8 | 第2放熱板 | 501 | 電極 |
| 9 | 外囲体 | 502 | パッシベーション膜 |
| 10 | 絶縁充填材 | 61, 62 | ワイヤ配線 |
| | | 71 | 第2高熱伝導性絶縁基板 |

フロントページの続き

(72)発明者 草野 貴史
東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
府中工場内

(72)発明者 山本 敦史
東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
府中工場内

(72)発明者 西村 隆宣
東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
府中工場内

(72)発明者 石渡 裕
神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目4番地
株式会社東芝京浜事業所内

(72)発明者 田中 明
神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目4番地
株式会社東芝京浜事業所内

(72)発明者 福吉 寛
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会
社東芝多摩川工場内

(72)発明者 荒木 浩二
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会
社東芝多摩川工場内

Fターム(参考) 5F036 AA01 BB01 BB05 BB08 BB21
BC05